3P041

プロトン化核酸塩基を用いた Ni(dmit)2 分子の配列制御

(名城大総研¹, 京大院理², 京大低物セ³)

○吉田幸大¹,前里光彦²,西村一国²,平松孝章³,矢持秀起³,齋藤軍治¹

【序】水素結合は生体分子設計において最も重要な分子間相互作用であり、例 えば二重鎖 DNA は対向核酸塩基間の相補的水素結合により安定化されている

[1]。水素結合による核酸塩基ならびにそのプロトン化体の 配列制御を利用した金属錯陰イオンの配列制御は数例報告 されている[2]が、錯陰イオンの電子物性(磁性、導電性、 光特性など)制御を試みた例はない。本研究では、cytosinium

(Hcyt⁺;図1)ならびに1-methylcytosinium (Me-Hcyt⁺;図1)を用いて2種類の新規1:1Ni(dmit)₂錯体(Hcyt)[Ni(dmit)₂](MeCN) (1)、(Me-Hcyt)[Ni(dmit)₂] (2)を作製し、Ni(dmit)₂⁻の構造配列と電子物性の相関について検討した。

図1 Hcyt⁺ (R = H) ならびに Me-Hcyt⁺ (R = Me)の分子構造

【実験】 錯体 1,2 の単結晶は、Hcyt·BF₄ もしくは Me-Hcyt·BF₄ と TBA·Ni(dmit)₂ を用いて、MeCN 中での拡散法により作製した。室温 X 線回折測定は CCD 型回 折計を用いて行った。電気伝導度は直流四端子法により、静磁化率は SQUID 磁 束計(印加磁場:5 kOe)を用いて測定した。

【結果と考察】 錯体 1 の結晶構造を図 2 に示す(三斜晶系 P1)。結晶学的に独立な分子は $Hcyt^+$ 、Ni(dmit)²、MeCN 各々1 分子であり、 $Hcyt^+$ は 2 本の N-H…O

水素結合を介して二量体 を形成している。 Ni(dmit)₂⁻は、短い C-H···S、N-H···S、O···S 原子間接触を介して、 (Hcyt⁺)₂(MeCN)₂1次元鎖 に挟まれて *a*-*c* 軸方向に 2本の二本足梯子を形成 している(重なり積分 s_1 = 3.77×10^{-3} , s_2 = -0.67×10^{-3} , $s_3 = 0.12 \times 10^{-3}$ $s_4 = -3.47 \times 10^{-3}$, s_6 = 0.32×10^{-3})。交換相互作用 $J \sim s^2$ と仮定すると、rung



図2 錯体1の結晶構造。点線は短い原子間接触を示し、 右下図は*S* = 1/2 二本足スピン梯子格子の模式図を示す。 方向($J_{\perp} \sim s_4^2$)とleg 方向($J_{//} \sim s_1^2$)の交換相互作用の比 $J_{\perp}/J_{//}$ (図 2b)は0.85 と見積もられ、また梯子間の $J (\sim s_2^2)$ は梯子内の値に比べ1桁以上小さく、錯 体1が理想的なS = 1/2 二本足スピン梯子格子物質であることが分かった。予備 的な静磁化率(χ)測定では、Troyer によって提唱されたS = 1/2 反強磁性 Heisenberg スピン梯子モデルと Curie-Weiss 則の和($\chi = \alpha T^{-1/2} \exp(-\Delta/T) + C/(T-\Theta)$) で表わされる温度依存性が観測され、スピンギャップ Δ は約 350 K と見積もられ た。Ni(dmit)₂⁻をS = 1/2 ユニットとしたスピン梯子格子としては、 (*p-N*-ethylpyridinium α -nitronyl nitroxide)[Ni(dmit)₂]($J_{\perp}/J_{//} = 1.7 \times 10^4$)[3]や (PhNH₃)(18-crown-6)[Ni(dmit)₂]($J_{\perp}/J_{//} = 8.1$)[4]が報告されている。Ni(dmit)₂⁻の 配列様式と $J_{\perp}/J_{//}$ 値の相関については当日報告する。また、錯体1は室温伝導度 $\sigma_{RT} = 2.5 \times 10^{-3}$ S cm⁻¹、活性化エネルギー $E_a = 63$ meV の半導体的挙動を示した。

錯体 2 の結晶構造を図 3 に示す(三斜晶系 P1)。結晶学的に独立な分子は Me-Hcyt⁺、Ni(dmit)² 各々1 分子であり、対称心上でディスオーダーした Me-Hcyt⁺ が2本の N-H…O水素結合を介してa軸方向に1次元鎖を形成している(図3a)。 これまで水素結合を介した様々な cytosine/cytosinium 配列様式が報告されている [2]が、ディスオーダーした cytosine/cytosinium が 1 次元鎖を形成した例はない。 各 Ni(dmit)²は末端チオケトン基を介して両隣 Me-Hcyt⁺と短い原子間接触

 $(C-H\cdots S, N-H\cdots S, O\cdots S)$ を もち、同じく a 軸方向に side-by-side 型 1 次元鎖を形成す る。鎖内の Ni(dmit)2⁻間重なり積 分は小さい($s_1 = 0.84 \times 10^{-3}$)が、 c 軸方向の最近接 Ni(dmit)₂-との 間に大きな重なり積分(図 3b; $s_2 = -3.98 \times 10^{-3}$)をもつ。静磁化 率の温度依存性は1次元S = 1/2 反強磁性 Heisenberg モデルの理 論曲線と一致する (J = -23.4 K)。 なお、錯体 2 も $\sigma_{\rm RT} = 5.2 \times 10^{-4}$ S cm⁻¹、*E*_a = 227 meV の半導体的挙 動を示した。以上の結果より、核 酸塩基の構造配列が錯体の電子 物性に与える影響を確認できた。



図3 錯体2の結晶構造。左下図では Me-Hcyt⁺の 位置を楕円で表わしている。点線は短い原子間接触 を示し、右下図はS = 1/21次元鎖の模式図を示す。

【参考文献】[1] J. L. Sessler *et al.*, *Chem. Soc. Rev.* **2007**, *36*, 314. [2] 例えば、J. P. García-Terán *et al.*, *Cryst. Growth Des.* **2007**, *7*, 2594. [3] H. Imai *et al.*, *Phys. Rev. B* **1996**, *54*, 6838. [4] S. Nishihara *et al.*, *Chem. Commun.* **2002**, 408.